

# 2SC2267H

シリコン NPN 三重拡散形

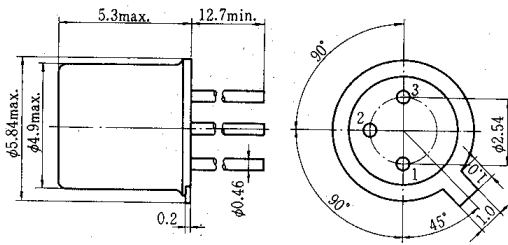
高電圧スイッチング用

2SA1024<sup>Ⓜ</sup> とコンプリメンタリペア

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

HIGH VOLTAGE SWITCHING

Complementary pair with 2SA1024<sup>Ⓜ</sup>



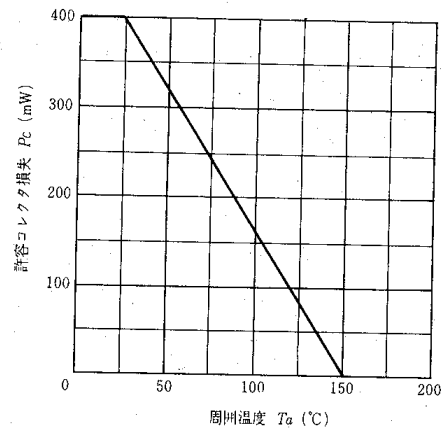
1. エミッタ: Emitter
  2. ベース: Base
  3. コレクタ: Collector
- (ケース) (Case)  
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-18)

## ■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	Symbol	2SC2267 <sup>Ⓜ</sup>	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	400	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	360	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	100	mA
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	500	mA
許容コレクタ損失	$P_C$	400	mW
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	400	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$	360	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=250\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	1.0	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE}=20\text{V}, I_C=20\text{mA}$	35	—	200	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}$	—	0.2	1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(\text{sat})}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}$	—	—	1.3	V
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}$	40	70	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	4.0	10	pF